

СООБЩЕНИЯ Объединенного института ядерных иссяедований дубна

P9-91-555

П.Г.Акишин, А.А.Ефремов, В.Б.Кутнер

РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ СТРУКТУРЫ ИОННОГО ИСТОЧНИКА DECRIS-14



ТРЕБОВАНИЯ К МАГНИТНОЙ СИСТЕМЕ

Источники иногозарядных ионов с нагревои плазиенных электронов в области электронно-циклотронного резонанса широко используются на различных ускорительных комплексах. Источник такого типа DECRIS-14 (Dubna Electron Cyclotron Resonance Ion Source) в настоящее время разрабатывается в ЛЯР ОИЯИ.

разраоатывается в ляг оили. В ионном источнике DECRIS-14 используется частота накачки 14 ГГц, что соответствует уровню резонансного пагнитного поля 0,5 Тл. Зона резонанса должна быть запкнутой и не пересекать стенки ионизационной камеры. Для удержания плазмы используется конфигурация "иининум В" или трехмерная "магнитная яма", т.е. поле, которое имеет мининум в области плазмы и возрастает во всех направлениях.

Для реализации такой конфигурации в ионном источнике используется конбинация полей, создаваеных осесимметричными соленоидальными катушками и мультиполем (в нашем случае гексаполем). изготовленным из постоянных магнитов (материал NdFeB). Катушки обеспечивают "яму" в аксиальном направлении с пробочным отношением 1,5 - 2, а мультиполь в радиальном. Уровень магнитного поля однозначно определяется значением резонансного магнитного поля. Так, максимум аксиального магнитного поля и значение радиального магнитного поля на поверхности ионизационной камеры должны составлять величину 0,7 - 0,8 Тл. Вследствие того, что стенка ионизационной. камеры находится на расстоянии 3 мм от поверхности магнита, а величина магнитного поля в гексаполе в ~ г, поле на поверхности магнита должно превышать 1 Тл.

Первоначальные расчеты магнитной конфигурации проводились С помощью пакета прикладных програми POISSON [1]. Входящая в этот пакет программа PANDIRA позволяет рассчитывать распределение магнитного поля в сечении бесконечно длинного гексаполя, а программа POISSON - осесииметричные магнитные системы, состоящие из катушек и мягкого железа. Однако наличие в магнитной системе мультиполя приводит к утрате осевой симметрии и требует дополнительных трехмерных расчетов, т.к. осевые поля (рис. 1), возникающие на краях гексаполя, могут привести к возникновению "паразитных" резонансов в районе экстракционного отверстия или в области ввода СВЧ-нощности.

> Объсяльевный виститут идерных истаедования БИБЛИЮТЕНА



МЕТОДИКА РАСЧЕТА

гексаполе (б).

использовался магнитного поля трехмерной конфигурации расчета Δля объемных интегральных уравнений [2]. Пусть В (a), Н (a), М (a) иетоД поля в точке а; напряженность и намагниченность магнитного индукция. - поле от токовых обноток; H^m(a) - поле от постоянных магнитов; H^S(a) область, заполненная ферронагнетиком. Тогда имеет место следующее **G** - интегральное уравнение:

 $H(a) = H^{s}(a) + H^{m}(a) + \frac{\nabla a}{4\pi} \left[\int \left(M(x), \nabla a \frac{1}{1 \times a!} \right) d\nabla x \right]$

Величины В, Н и И связаны соотношениями: M = B/40 -H; $H = [\mu(|B|)\mu_0]^{-1}B_{\mu}$ - нагнитная проницаемость вакууна магнитная где Область G OT IBI . зависящая образон нелинейным проницаемость, $(G_i): G = U G_i.$ G, берется B каждон разбивается на подобласти 1=1 центроид а; В, Н, М в С, приближаются постоянными значениями В, Н, и М... Итоговая дискретизованная система уравнений имеет вид: $H_{i} = H^{s}(a_{i}) + H^{m}(a_{i}) + \frac{\nabla a}{4\pi} \left(\sum_{i=1}^{n} \int \left(M_{j}, \nabla a \frac{1}{1 \times -a^{1}} \right) dV_{x} \right) \Big|_{a=a}, i=1,2,..N.$

В дальнейшем использовался метод, изложенный в работе [3].

время на 3456 элементов. Суммарное разбивалась Область процесса итерационного шагов 100 коэффициентов матрицы, вычисление около 22.15 23 часов составило наблюдения 8000 точек пересчета поля ΠB. центрального процессора ЭВМ ЕС-1056.

はいいも子の子

на

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

показана систены монного источника Конфигурация магнитной TTST IF



Рис. 2. Конструкция источника иногозарядных монов DECRIS-14.

化学校会议 医二硫酸化合物 педных karymek, соленоидальных себя 8 включает Она рисунке 2 магнитного поля Распределение железа. МЯГКОГО и элененты ЮЗ гексаполь на рисунке 3, где приведены кривые, ионного / источника показано на оси и результаты трехмерного POISSON программы рассчитанные с помощыю магнитного приводятся результаты изперении Kpone TOFO, расчета. Как видно _ в [4]. магнитометра, описанного понощью поля, проведенные с удовлетворительное совпадение расчетов С рисунка, имеется вполне экспериментальными данными.

используется магнитного поля Для создания возрастающего ΠΟ. радиусу 4. Δля TOLO рисунке гексаполь, конструкция которого показана на поля магнитного чтобы обеспечить необходимую величину модуля обеспечивающая конфигурация, использована ионизационной канере концентрацию магнитного потока внутри рабочей области. 0 - 329-238 • Conf



измерения

гексаполе

B

Различие расчетной и эксперинентальной кривых в некоторых областях связано с разбросой характеристик нагнитного натериала.



Рис. 5. Распределение радиальной кон- Рис. 6. Топография магнитнопоненты магнитного поля вдоль го поля в продольном оси гексаполя (r=30.4 nn). сечении источника.



Рис. 7. Топография магнитного поля Рис. 8. Трехмерное распределев поперечных сечениях ионизационной камеры. индукции в ионизационной камере.

Проведение трехмерных расчетов позволяет определить положение резонансной зоны в любом из сечений ионизационной камеры (рис. 6, 7), а также построить трехмерную картину распределения модуля магнитного поля в рабочей области, наглядно отражающую особенности магнитной системы (рис. 8).

Литература

- 1.User's guide for the POISSON/SUPERFISH group of codes, Los Alamos accelerator code group, LA-UR-87-115, 1987.
- Newman M.J., Trowbridje C.W., Turner L.R. GFUN: An interactive program as an aid to magnet design, Proc. 4th Int. Conf. Magnet Technol., Brookhaven, 1972, p. 617-626.
- 3. Акишин П.Г. ІВМ и МФ, Т. 29, 1989, с. 1168-1174.
- 4. Ефренов А.А. и др. Тезиси докладов XII Всесовзного совещания по ускорителян заряженных частиц, Москва, ИТЭФ, 1990, стр.44-45. Рукопись поступила в издательский отдел

18 декабря 1991 года.

4